15.02.99

IP99/676

EJKU

日本国特許

PATENT OFFICE
JAPANESE GOVERNMENT

REC'D 0 6 APR 1999
WIPO PCT

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 Date of Application:

1998年 2月16日

出 願 番 号 Application Number:

平成10年特許願第050138号

出 願 人 Applicant (s):

株式会社小松製作所

PRIORITY DOCUMENT

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

1999年 3月19日

特許庁長官 Commissioner, Patent Office 保佐山建門

【書類名】

特許願

【整理番号】

PK980017

【提出日】

平成10年 2月16日

【あて先】

特許庁 長官殿

【国際特許分類】

H01L 21/00

【発明の名称】

基板温度制御装置

【請求項の数】

23

【発明者】

【住所又は居所】

神奈川県平塚市万田1200 株式会社小松製作所研究

所内

【氏名】

門谷 ▲かん▼ー

【発明者】

【住所又は居所】

神奈川県平塚市万田1200 株式会社小松製作所研究

所内

【氏名】

大沢 昭浩

【特許出願人】

【識別番号】

000001236

【氏名又は名称】

株式会社 小松製作所

【代表者】

安崎 暁

【代理人】

【識別番号】

100095371

【弁理士】

【氏名又は名称】

上村 輝之

【代理人】

【識別番号】

100089277

【弁理士】

【氏名又は名称】

宮川 長夫

【手数料の表示】

【予納台帳番号】

043557

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書 1

【包括委任状番号】 9605173

【書類名】

明細書

【発明の名称】

基板温度制御装置

【特許請求の範囲】

【請求項1】 基板に面する主面を有した平板状のステージを備え、

前記ステージは平板状の容器を有し、前記容器は、作動流体を流すための空洞と、この空洞に前記作動流体を流入させるための入口と、前記空洞から前記作動流体を排出するための出口と、前記空洞内に前記作動流体の乱流を生じさせるための乱流機構とを有している基板温度制御装置。

【請求項2】 前記乱流機構が、前記空洞内で前記容器の前記主面の側の壁と逆側の壁とを繋いでいる複数のリブを有している請求項1記載の基板温度制御装置。

【請求項3】 前記乱流機構が、前記作動流体を前記空洞に流入するときに ジェット流にするジェット口を有する請求項1記載の基板温度制御装置。

【請求項4】 前記乱流機構が、前記作動流体を前記空洞に流入するときに 所定の旋回方向へ向けさせる旋回機構を有している請求項1記載の基板温度制御 装置。

【請求項5】 前記入口と出口の配置が次の(1)、(2)及び(3)、

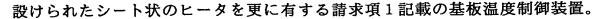
- (1) 前記入口が前記容器の周縁部の複数箇所に設けられ、前記出口が前記容器の中央部に設けられている、
- (2) 前記入口が前記容器の中央部に設けられ、前記出口が前記容器の周縁部 の複数箇所に設けられている、
- (3) 前記入口及び前記出口がそれぞれ前記容器の周縁部の複数箇所に設けられている、

のいずれか一方である請求項1記載の基板温度制御装置。

【請求項6】 前記入口が前記容器の外周壁に、前記容器の前記主面側の壁と平行な方向を向いて設けられた請求項5記載の基板温度制御装置。

【請求項7】 前記入口が前記周縁部に設けられ、前記周縁部が、前記基板の外周外へ張り出した位置にある請求項5記載の基板温度制御装置。

【請求項8】 前記ステージが、前記容器の前記主面側の面及び逆側の面に



【請求項9】 前記作動流体を前記容器に供給するための作動流体システムを更に備え、この作動流体システムが、基板冷却用の作動流体のみを供給する請求項8記載の基板温度制御装置。

【請求項10】 基板に面する主面を有した平板状のステージを備え、

前記ステージは平板状の容器を有し、前記容器は、作動流体を流すための空洞と、この空洞に前記作動流体を流入させるための入口と、前記空洞から前記作動流体を排出するための出口とを有し、

前記入口と出口の配置が次の(1)、(2)及び(3)、

- (1) 前記入口が前記容器の周縁部の複数箇所に設けられ、前記出口が前記容器の中央部に設けられている、
- (2) 前記入口が前記容器の中央部に設けられ、前記出口が前記容器の周縁部の複数箇所に設けられている、
- (3) 前記入口及び前記出口がそれぞれ前記容器の周縁部の複数箇所に設けられている、

のいずれか一方である基板温度制御装置。

【請求項11】 前記容器が、前記空洞内に前記作動流体の乱流を生じさせるための乱流機構を更に有している請求項10記載の基板温度制御装置。

【請求項12】 前記ステージが、前記容器の前記主面側の面及び逆側の面に設けられたシート状のヒータを更に有する請求項10記載の基板温度制御装置

【請求項13】 前記作動流体を前記容器に供給するための作動流体システムを更に備え、この作動流体システムが、基板冷却用の作動流体のみを供給する 請求項12記載の基板温度制御装置。

【請求項14】 基板に面する主面を有した平板状のステージを備え、

前記ステージは平板状の容器を有し、前記容器は、作動流体を流すための空洞と、前記空洞内で前記容器の前記主面の側の壁と逆側の壁とを繋いでいる複数の リブとを有している基板温度制御装置。

【請求項15】 前記容器が、前記空洞内に前記作動流体の乱流を生じさせ

るための乱流機構を更に有している請求項14記載の基板温度制御装置。

【請求項16】 前記容器が、前記空洞に前記作動流体を流入させるための 入口と、前記空洞から前記作動流体を排出するための出口とを有し、前記入口と 出口の配置が次の(1)、(2)及び(3)、

- (1) 前記入口が前記容器の周縁部の複数箇所に設けられ、前記出口が前記容器の中央部に設けられている、
- (2) 前記入口が前記容器の中央部に設けられ、前記出口が前記容器の周縁部の複数箇所に設けられている、
- (3) 前記入口及び前記出口がそれぞれ前記容器の周縁部の複数箇所に設けられている、

のいずれか一方である請求項14記載の基板温度制御装置。

【請求項17】 前記ステージが、前記容器の前記主面側の面及び逆側の面に設けられたシート状のヒータを更に有する請求項14記載の基板温度制御装置

【請求項18】 前記作動流体を前記容器に供給するための作動流体システムを更に備え、この作動流体システムが、基板冷却用の作動流体のみを供給する 請求項15記載の基板温度制御装置。

【請求項19】 基板に面する主面を有した平板状のステージを備え、 前記ステージは、作動流体を流すための空洞を内部にもった平板状の容器と、 前記容器の前記主面側の面及び逆側の面の双方に設けられたシート状のヒータと を有している基板温度制御装置。

【請求項20】 前記容器が、前記空洞内で前記容器の前記主面の側の壁と逆側の壁とを繋いでいる複数のリブを有している請求項19記載の基板温度制御装置。

【請求項21】 前記容器が、前記空洞内に前記作動流体の乱流を生じさせるための乱流機構を更に有している請求項19記載の基板温度制御装置。

【請求項22】 前記容器が、前記空洞に前記作動流体を流入させるための入口と、前記空洞から前記作動流体を排出するための出口とを有し、前記入口と出口の配置が次の(1)、(2)及び(3)、

- (1) 前記入口が前記容器の周縁部の複数箇所に設けられ、前記出口が前記容器の中央部に設けられている、
- (2) 前記入口が前記容器の中央部に設けられ、前記出口が前記容器の周縁部の複数箇所に設けられている、
- (3) 前記入口及び前記出口がそれぞれ前記容器の周縁部の複数箇所に設けられている、

のいずれか一方である請求項19記載の基板温度制御装置。

【請求項23】 前記作動流体を前記容器に供給するための作動流体システムを更に備え、この作動流体システムが、基板冷却用の作動流体のみを供給する請求項19記載の基板温度制御装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、半導体ウェハや液晶パネルなどの基板の処理工程において、基板を 加熱したり冷却したりして基板温度を制御するための装置に関する。

[0002]

【従来の技術】

例えば半導体製造工程では、例えばレジスト塗布時に水分やレジスト溶媒を除去するためにウェハを加熱しその後に冷却するというように、ウェハの加熱や冷却が頻繁に行われる。この半導体ウェハのような基板の加熱・冷却に用いられる装置は、一般に、基板を載置する上面の平らなステージを有し、このステージ内またはステージ下に加熱や冷却の熱源デバイスが配置されている。加熱デバイスとしては電熱線や赤外線ランプや作動流体などが知られており、冷却デバイスとしては作動流体が一般に用いられている。また、ステージにパネル状ヒートパイプを用いた装置も知られている。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】

基板温度制御装置に一般に要求される性能として、第1に、熱応答性の良さ、 加熱冷却の高速性、温度制御性の良さなどと呼ばれる要素がある。要するに、迅 速に所望の温度が達成できる能力である。そのためには、ステージの熱容量を小さくすることが重要である。第2に、均熱性と呼ぶことができる要素がある。これは、基板全体を温度むらなく同一の温度に制御できる能力である。そのためには、熱源デバイスの選択や配置や作用させ方などを工夫する必要がある。また、ステージの熱膨張による歪みに起因する温度むらの問題も考慮する必要がある。第3に低価格であること、第4に安全性が高いといったことも、重要な要素であることは言うまでもない。

[0004]

本発明の目的は、熱応答性が良く且つ低価格な基板温度制御装置を提供することにある。

[0005]

本発明の別の目的は、熱応答性が良く且つ均熱性も良い基板温度制御装置を提供することにある。

[0006]

本発明のまた別の目的は、熱応答性が良く、均熱性も良く、且つ低価格である基板温度制御装置を提供することにある。

[0007]

本発明のさらに別の目的は、均熱性が良い基板温度制御装置を提供することにある。

[0008]

本発明のまた別の目的は、均熱性が良く且つ低価格な基板温度制御装置を提供することにある。

[0009]

本発明のさらにまた別の目的は、熱応答性が良く、均熱性の良く、低価格で、 且つ安全性も高い基板温度制御装置を提供することにある。

[0010]

【課題を解決するための手段】

本発明の第1の側面に従う基板温度制御装置は、基板に面する主面を有した平板状のステージを備え、このステージは平板状の容器を有し、この容器は、作動

流体を流すための空洞と、作動流体の入口及び出口と、空洞内に作動流体の乱流を生じさせるための乱流機構とを有している。この装置によれば、容器の空洞内に作動流体が乱流となって流れるので、良好な均熱性と熱応答性とが得られる。なお、上記「主面」とは、基板をステージ上に載置する場合はステージ上面であるが、基板をステージにバキューム等で吸い付けるような場合は、ステージは様々な姿勢がとれるようになるので、そのような場合も含めて基板が配置される側のステージ面を指すものである。

[0011]

乱流機構として、好適な実施形態では、空洞内に容器の主面側壁と逆側壁とを繋ぐリブを複数設けて、このリブで流体の流れをかき乱すようにしているいる。また、このリブは、容器の基板の機械的強度を高めて流耐圧力による容器の変形を防止するので、このことも均熱性の向上に寄与する。更に、好適な実施形態では、作動流体がジェット流にして空洞内へ噴出させたり、旋回流にしたりすることによって、更に積極的に乱流を生じさせて、均熱性と熱応答性の向上を図っている。

[0012]

また、好適な実施形態では、入口と出口の配置を、入口を容器周縁部の複数箇所に設け、出口を容器の中央部に設けるか、又はその逆の配置にするか、又は入口と出口をそれぞれ容器周縁部の複数箇所に設けることによって、作動流体の温度分布が容器内でできるだけ均等になるようにしており、そのことも均熱性の向上に寄与する。さらに、入口を容器外周壁に容器主面側壁と平行な方向を向けて設けたり、或いは、入口を設けた容器周縁部を基板の外周外へ遠く張り出した位置になるようにしたりすることにより、流入当初の作動流体の強い熱作用が局所に集中しないよう配慮し、それにより均熱性の向上を図っている。

[0013]

また、好適な実施形態では、容器の主面側面及び逆側面の一方又は双方にシート状のヒータを設け、そして、加熱はこのシート状ヒータで行い、冷却は作動流体で行うようにしている。このようなシンプルな構造のステージは、その熱容量がかなり小さくなるように設計できるので、良好な熱応答性を得ることができる

。また、作動流体を冷却にみに使用するようにすれば、作動流体システムが簡素 化できるので、かなり安価になる。

[0014]

本発明の第2の側面に従う基板温度制御装置は、基板に面する主面を有した平板状のステージを備え、このステージは平板状の容器を有し、この容器は、作動流体を流すための空洞と、作動流体の入口及び出口とを有し、入口と出口の配置は、入口が容器周縁部の複数箇所に設けられ、出口が容器中央部に設けられるか、又はその逆の配置か、又は入口も出口も容器周縁部の複数箇所に設けられるようになっている。この装置によれば、作動流体が容器の周縁から中央へ又はその逆へと放射状に、あるいはその往復方向へと流れるので、作動流体の温度分布がかなり均等になり、均熱性が向上する。特に入口が複数箇所にある構成では、それら複数の入口からの流れが互いに交錯し合って乱流となるので、より良好な均熱性および熱応答性が期待できる。

[0015]

更に、前述したような乱流機構を設ければ、熱応答性も向上し、均熱性もいっそう向上する。また、容器の主面側面及び逆側面の一方又は双方にシート状ヒータを設け、加熱はこのヒータで行い、冷却のみを作動流体で行うようにすれば、かなり安価になる。

[0016]

本発明の第3の側面に従う基板温度制御装置は、基板に面する主面を有した平板状のステージを備え、このステージは平板状の容器を有し、この容器は、作動流体を流すための空洞と、空洞内で容器の主面側壁と逆側壁とを繋いでいる複数のリブとを有している。この基板温度制御装置によれば、リブによって容器の機械的強度を高めているので、容器内に高圧の作動流体を供給して作動流体を高速に流すことができ、且つリブが乱流を生じさせるので、良好な熱応答性と均熱性を得ることができる。この装置でも、既に説明した乱流機構や入口・出口配置やヒータとの組み合わせなどを採用することにより、いっそうの性能向上や低価格化の効果を得ることができる。

[0017]

本発明の第4の側面に従う基板温度制御装置は、基板に面する主面を有した平板状のステージを備え、このステージは、作動流体を流すための空洞を内部にもった平板状の容器と、この容器の主面側面及び逆側面の双方に設けられたシート状のヒータとを有している。この基板温度制御装置によれば、ステージが主面側と逆側について熱的及び機械的に対称な構造であるため、熱膨張によるステージの歪み又は撓みが減り、均熱性が向上する、この装置でも、上述した様々な工夫を加えることにより、さらなる性能向上や低価格化の効果を得ることができる。

[0018]

【発明の実施の形態】

図1は本発明の一実施形態にかかる基板温度制御装置のステージ部分の側断面図、図2は図1のA-A線での平断面図である。なお、図中の各部の寸法比率は、図面を分かりやすくするために実際の装置とは異なっており、このことは後述する他の図面についても同様である。

[0019]

ステージ1は全体として円形の薄い板状体であり、その平らな上面上に円形の基板、典型的には半導体ウェハ3が載置される。ステージ1の上面には数箇所に同一高さ(例えば0.1mm)の小さな突起5があり、これらの突起5がウェハ3を支えて、ウェハ3との接触を防止している(これは、ウェハ3のステージ1からの汚染を防止するためである)。ステージ1は概略次の2つの層から構成されている。第1の層はステージ1の上面を構成する円形シート状の薄膜ヒータ(プリント配線技術によって絶縁フィルムにラミネート又は埋め込まれた電熱線ヒータ)7であり、第2の層は内部に作動流体を流すための薄い円盤形の容器9であり、薄膜ヒータ7は容器9の上面に貼り付けられている。

[0020]

容器 9 は、その内部の全域に作動流体を通すための空洞 1 1 を有しており、アルミニウムや銅合金のような熱伝導性の良好な材料の薄板を用いて、例えば、 2 枚の薄板をその周縁部でろう接する方法や、或いはその他の方法によって作られている。この容器 9 の底壁には、周縁部の複数箇所に、作動流体を空洞 1 1 に供給するための入口 1 7 が、中央の一個所に、作動流体を空洞 1 1 から排出するた

めの出口19がそれそれ開けられており、そして、各入口17の箇所には流体供 給管13が、出口19の箇所には流体排出管15がそれぞれ結合されている(な お、これとは逆に中央の穴19を入口とし、周縁の穴17を出口としてもよいが 、均熱性の観点からは本実施形態のように周縁部から流入させて中央から流出さ せる方が好ましいと考えられる)。空洞11内には、多数の箇所に、底壁と天井 壁とを繋ぐリブ21が立てられている。このリブ21の一つの目的は、容器1の 機械強度を高めて、特に作動流体の圧力による容器9の膨らみを防止することで ある。これにより、高圧の作動流体を供給して高速に流せるので、良好な熱応答 件および均熱性を達成できる。また、リブ21の第2の目的は、空洞11内の作 動流体の流れを乱して乱流を生じさせて、熱交換効率を高め且つ均熱性も良好に することである。これらの目的及び製造上の観点から、リブ21もアルミニウム や銅合金のような熱伝導性が良く且つろう接などの接合加工が容易な材料が好ま しい。作動流体としては、例えば、水、エチレングリコール、プロピレングリコ ール、ガルデン(登録商標)あるいはフロリナート(登録商標)などを用いるこ とができる。空洞11は、基本的には、外気との通気のない密閉形であって、作 動流体が空洞11を完全に満たした状態で流れる。しかし、空洞11が、外気と の通気がある開放型であって、そこを作動流体が空気との混合体や噴霧のような 形態で流れるようになっていてもよい。

[0021]

容器 9 は、主として、冷えた(例えば常温程度の)作動流体を空洞 1 1 に通してウェハ3を冷却するために用いられる。ウェハ3の加熱は薄膜ヒータ7で行う。勿論、高温の作動流体を容器 9 内に流して、これを積極的に加熱に用いることも可能である。しかし、低価格と安全確保のし易さという観点からは、作動流体は積極的な加熱(特に100℃や200℃のような高温域での加熱)には用いない方が好ましい。その第1の理由は、作動流体の循環システムは元々最も高価な要素の一つであるが、冷却は他に適当な代替手段がないので作動流体システムを使わざるを得ないが、加熱は安価な電熱線ヒータで代替することにより、作動流体システムから高価な流体加熱装置が除去でき、それによる価格低下は大きいからでる。第2の理由は、作動流体システムに100℃や200℃の高温の流体が

流れる場合には厳重な安全対策が必要であるが、冷えた作動流体が流れるだけなら ら厳重な安全対策は不要なので、やはり、かなりの低価格化が望めるからである

[0022]

本実施形態によれば、良好な熱応答性と良好な均熱性と上述の低価格という利 点を得ることができる。熱応答性を良好にできる第1の理由は、ステージ1の熱 容量が非常に小さくできるからである。すなわち、ステージ1は容器9と薄膜ヒ - タ7という単純な構成であり、その熱容量の殆どは容器9のそれが占める。容 器9の壁や内部の空洞11は、図ではかなり分厚いが、実際にはどれも非常に薄 く作ることができ、かなり小さい熱容量にすることができる。なお、空洞11を 薄くした分、作動流体の流速を上げて流量を低下させなければ、高い熱交換量を 維持できる。第2の理由は、リブ21の作用によって、及び図2に矢印で示すよ うに複数の入口17からの流れが互いに交錯することによって生じる乱流のため に、作動流体の熱交換率が高くなるからである。第3の理由は、リブ21の存在 によって容器 9 が堅牢になっているので、高圧の作動流体を供給して高速に作動 流体を流し得るため、容器9内での作動流体の交換が迅速であり、且つ乱流も一 層激しくなるので、大きい熱交換量が得られるからである。均熱性が良好にでき る第1の理由は、リブ21による乱流により温度分布むらが解消されるからであ る。第2の理由は、高速に作動流体が流せるので、容器9内での作動流体の交換 が迅速であり、且つ乱流も一層激しくなり、温度むらが減るからである。

[0023]

図3は第2の実施形態のステージの側断面図であり、図4は図3のA-A線による同ステージの平断面図である。なお、図1、2と機能的に同じ要素には同一の参照番号を付してあり、このことは後述する他の図面でも同様である。

[0024]

本実施形態は、図1、2に示した前述の実施形態から改良した次の2つの特徴を有している。第1の特徴は、容器33の上面だけでなく下面にも、上面の薄膜ヒータ7と同サイズで同熱量の薄膜ヒータ35が貼り付けられていることである。上下の薄膜ヒータ7、35は原則として同時に使用される。これにより、ステ

ージ3 1 は熱的及び機械的に概略上下対称の構造となるので、加熱・冷却時の熱膨張によるステージの歪み又は撓みが抑えられる。ステージ3 1 が熱膨張で歪んだり撓んだりすると、ウェハ3とステージ3 1 間のギャップ長(ステージ3 1 上面が平らな状態では突起5の高さ、例えば0.1 mm、で一定である)が場所によって異なるようになり、ウェハ5の温度分布にむらができてしまう(例えばギャップ長が0.1 mm違うだけで4 0 K程度もの温度相違が生じる)。よって、ステージ3 1 の歪みや撓みを抑えることは、均熱性を向上させるのに大きく貢献する

[0025]

第2の特徴は、容器33がウェハ3のそれよりもずっと大きい外径を有していてウェハ3の外周外へ大きく張り出しており、この張り出した部分の最も外側にある輪状の周縁部分37の底壁に作動流体の入口17が設けられている点である。この輪状の周縁部分37は、容器33の他の部分と同じ材料(例えばアルミニウムや銅合金など)で作られてもよいが、以下に述べる熱的な作用効果の観点からは、例えばセラミックスのような熱伝導性の悪い素材で作られる方が好ましい。周縁部分37の入口17から流入した作動流体は、この周縁部分37の天井壁に当たって流れ方向を曲げられて、中心へ向かって流れていく。図1に示した前の実施形態では入口17からの作動流体が当たる天井壁部分が局所的に流体の熱作用を受け過ぎてウェハ3の温度むらの原因となるおそれがあるのに対し、本実施形態では、入口17からの作動流体が当たる天井壁はウェハ3からかなり離れた場所にあり且つその熱伝導性は悪いので、ウェハ3の温度に及ぼす影響はずっと小さい。従って、より良好な均熱性が得られる。

[0026]

図5は第3の実施形態のステージの側断面図であり、図6は図5のA-A線による同ステージの平断面図である。

[0027]

本実施形態では、ステージ51の容器53が、図3、4に示した第2実施形態の容器33の構成に加えて、空洞11を周縁部37内の部分と周縁部37より中央側の部分とに仕切る輪状の隔壁55をさらに有している。この隔壁55には、

周縁部37内に流入した作動流体をジェット流にして中心へ向けて送るための多数(図示では10個に過ぎないが、より多数でよい)のジェットロ59が設けられている。隔壁55も、容器53の本体と同じ材料製(例えばアルミニウムや銅合金など)でもよいが、熱的な影響を減らすためにセラミックスのような熱伝導性の悪い素材で作られてもよい。図6に示すように、多数のジェットロ59からそれぞれ異なる方向へジェット流が勢い良く吹き出るので、以前の実施形態よりも激しく作動流体の交錯及び混じり合いが生じ、また乱流も激しくなるので、一層の均熱性と熱応答性の向上が期待できる。

[0028]

図7は第4の実施形態のステージの側断面図であり、図8は図7のA-A線による同ステージの平断面図である。

[0029]

本実施形態では、ステージ61の容器63の周縁壁に多数(図示では12個に 過ぎないが、より多数でよい)のジェットロ67を設けてそこに供給管13を結 合し、それら多数のジェットロ67から空洞11内のそれぞれ異なる方向へ作動 流体のジェット流を噴出させるようにしたものである。図5、6に示した実施形 態と同様に、良好な均熱性と熱応答性が期待できる。

[0030]

図9は第5の実施形態のステージの側断面図であり、図10は図9のA-A線による同ステージの平断面図である。

[0031]

本実施形態は、ステージ71の容器73内の空洞11に中心から外周方向へ作動流体を流すようにしたものである。容器73の底壁の中心部に流体の入口75があり、空洞11内には、この入口孔75に対応する領域を囲んで輪状の隔壁77がある。この隔壁77には、入口孔75から流入した作動流体をジェット流として外周方向へ放射状に吹き出すための多数のジェット口79が開けられている。また、容器73の最も外周側の周縁部81は、ウェハ3から外方へ大きく張り出した位置にあって、この周縁部81の内部にはリブ21がなく流体が流れ易い輪状の流露路を構成している。隔壁77や周縁部81は、容器53の他の部分と

同じ材料製(例えばアルミニウムや銅合金など)でもよいが、熱的な影響を減らすためにセラミックスのような熱伝導性の悪い素材で作られてもよい。図10に矢印で示すように、作動流体は中央の多数のジェット穴79から空洞11内のそれぞれ異なる方向へジェット流となって噴出し、互いに交錯し合い且つリブ21と衝突して激しい乱流となって空洞11内を流れ、最終的には周縁部81内を通って排出管85へ流出する。本実施形態でも、良好な熱応答性と均熱性とが期待できる。

[0032]

図11は第6の実施形態のステージの容器の平断面図である。

[0033]

本実施形態は、図7、8に示した実施形態の変形であって、ジェットロ67の方向を円周接線側方向へ傾けさせて、ジェットロ67からの作動流体のジェット流が空洞11内で一回転方向へ向かって旋回流を形成するようにしたものである。同様の旋回流は、他の実施形態においても、入口17又はジェットロ59、79の方向を円周接線方向へ傾けさせることにより形成することができる。この旋回流によって乱流がいっそう発生し易くなり、いっそうの熱応答性と均熱効果の向上が期待できる。

[0034]

図12は第7の実施形態のステージの容器の平断面図である。

[0035]

ステージ101の容器103内では、ウェハの真下に位置する空洞11の外周に、隔壁105を介して、流体を排出するための輪状の流体通路107があり、さらにその外周に、隔壁109を介して、流体を供給するための輪状の流体通路111がある。内側の排出用流体通路107の底壁には、複数箇所に流体出口19が開いている。この通路107の内側の隔壁105の複数箇所に、空洞11内の流体を通路107へ吸込むための吸込口115が開いている。外側の供給用流体通路109の底壁には、複数箇所に流体入口17が開いている。この通路110内側の隔壁109の複数箇所には、そこから接続管117を通り内側の隔壁105を貫通して、作動流体を空洞11内へ噴出するためのジェット口119が

開いている。

[0036]

矢印で図示するように、空洞外周の複数のジェット口119から作動流体のジェット流が空洞中心へ向かって勢い良く噴き出す。また、空洞中心から外周へ向かう流れ方向で作動流体が吸込口115へ導かれ排出される。本実施形態でも、良好な熱応答性と均熱性が得られる。なお、流体の供給、排出は、上記とは逆に、内側の通路107から供給して外側の通路11へ排出するようにしてもよい。

[0037]

ところで、図6、8、10、11、12に示した実施形態において、ジェット口59、67、79、119の形状を、図13に断面図で示すジェット口121のように出口がラッパ状に拡がっていく形状とすることができる。このようなジェット口121を用いると、そこから噴出するジェット流が空洞内で放射状に効果的に拡がり、且つ複数のジェット口からのジェット流の交錯もいっそう良好になるので、均熱性及び熱応答性の向上に有効であると考えられる。

[0038]

以上、代表的な実施形態を幾つか説明したがこれらは本発明の説明のための例示に過ぎず、本発明の範囲をこれらの実施形態にのみ限定しようとする趣旨ではない。本発明は、その要旨を逸脱することなしに、上記実施形態とは異なる構成又は作用をもった種々の形態でも実施することができるものである。例えば、上記実施形態ではステージの上面にウェハを重力の作用で置くことを前提として説明したが、バキュームなどでステージに基板を吸い付ける構成を採用した場合には、ステージの姿勢は上記実施形態とは上下逆さであったり垂直に立っていたり傾いていたりすることも可能であるが、その場合にも本発明は適用できるものである。

【図面の簡単な説明】

【図1】

本発明の第1の実施形態にかかる基板温度制御装置のステージ部分の側断面図

【図2】

図1のA-A線での平断面図。

【図3】

本発明の第2の実施形態にかかる基板温度制御装置のステージ部分の側断面図

【図4】

図3のA-A線での平断面図。

【図5】

本発明の第3の実施形態にかかる基板温度制御装置のステージ部分の側断面図

【図6】

図5のA-A線での平断面図。

【図7】

本発明の第4の実施形態にかかる基板温度制御装置のステージ部分の側断面図

【図8】

図7のA-A線での平断面図。

【図9】

·本発明の第5の実施形態にかかる基板温度制御装置のステージ部分の側断面図

【図10】

図9のA-A線での平断面図。

【図11】

本発明の第6の実施形態にかかる基板温度制御装置のステージ部分の容器の平 断面図。

【図12】

本発明の第7の実施形態にかかる基板温度制御装置のステージ部分の容器の平 断面図。

【図13】

ジェットロの断面形状を示す図。

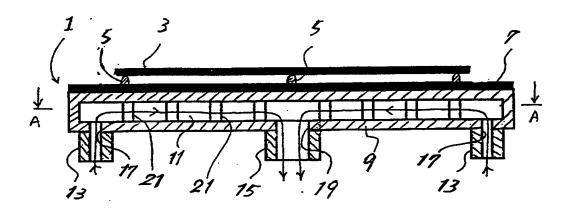
【符号の説明】

- 1、31、51、61、71、91、101 ステージ
- 3 半導体ウェハ
- 7、35 薄膜ヒータ
- 9、33、53、63、73、93、103 容器
- 11 空洞
- 17、75 入口
- 19、83 出口
- 21 リブ
- 37、81 容器の周縁部
- 55、77、105、109 隔壁
- 59、67、79、119 ジェットロ

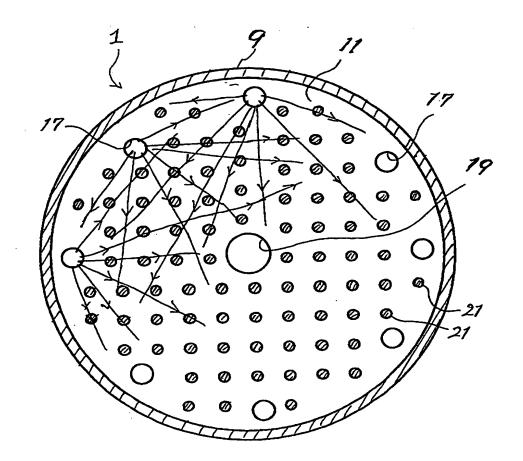
【書類名】

図面

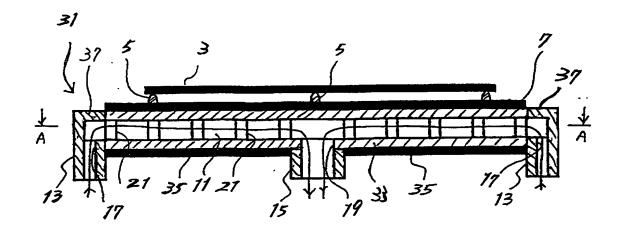
【図1】



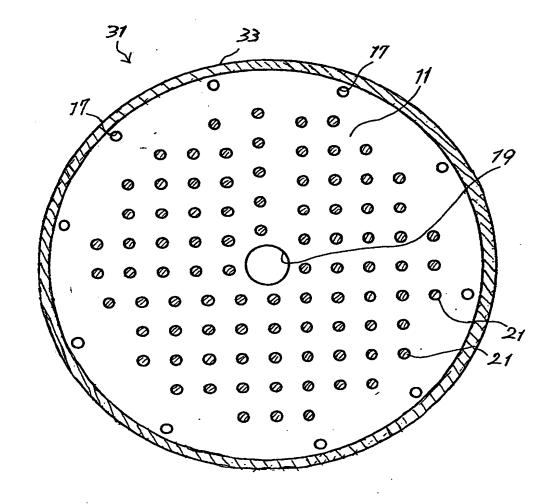
【図2】



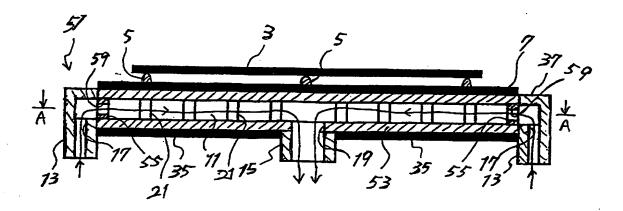
【図3】



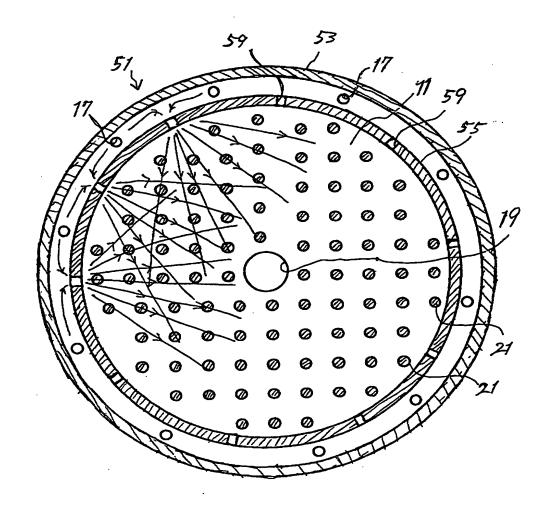
【図4】



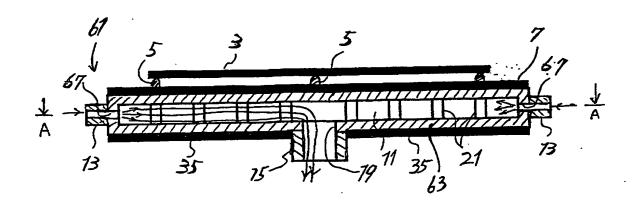
【図5】



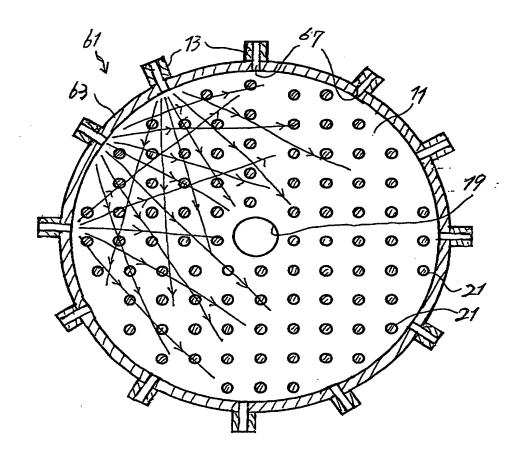
【図6】



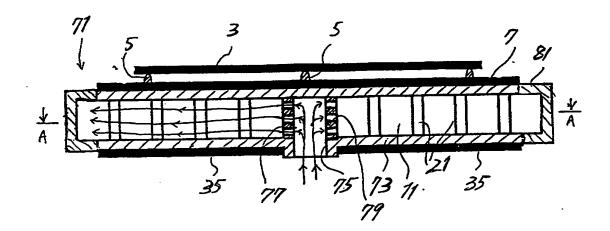
[図7]



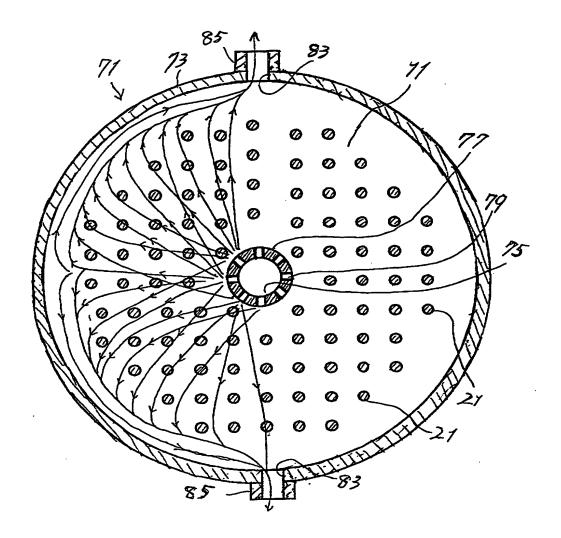
【図8】



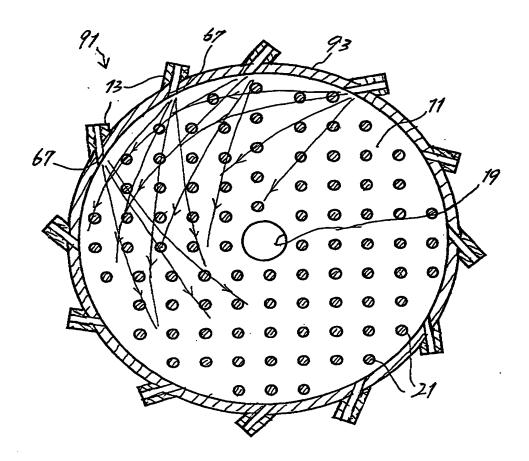
【図9】



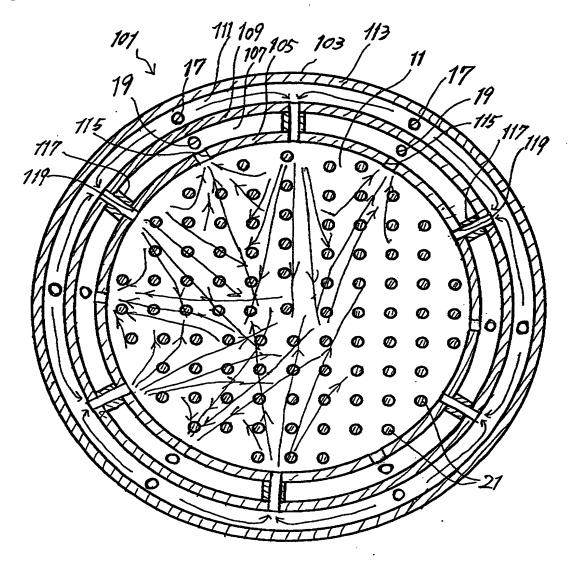
【図10】



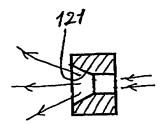
【図11】



【図12】



【図13】



【書類名】

要約書

【要約】

【課題】 良好な熱応答性と良好な均熱性と低価格と達成する。

【解決手段】 半導体ウェハ3を載せるステージ51は、熱伝導性の良い金属製の薄平板状の容器53と、この容器53の上面と下面に貼り付けられた薄膜ヒータ7、35とから成る上下対称の構造を有する。この対称構造は、ステージ51の熱膨張による撓みを防止して均熱性を高める。容器53内には、冷却用の作動流体を流すための空洞11があり、空洞11内には多数のリブ21があり、容器53の機械的強度を高めている。容器53周縁部の多数の入口17から高圧の作動流体が流入し、ジェット口59を通って高速ジェット流として空洞11内に供給され、互いに交錯し合い且つ多数のリブ21に当たって激しい乱流を生じて熱交換効率及び均熱性を高める。

【選択図】

図 5

特平10-050138

【書類名】

職権訂正データ

【訂正書類】

特許願

<認定情報・付加情報>

【特許出願人】

【識別番号】

000001236

【住所又は居所】

東京都港区赤坂二丁目3番6号

【氏名又は名称】

株式会社小松製作所

【代理人】

申請人

【識別番号】

100095371

【住所又は居所】

東京都墨田区江東橋1丁目8番3-702号 ウィ

ルフォート国際特許事務所

【氏名又は名称】

上村 輝之

【代理人】

申請人

【識別番号】

100089277

【住所又は居所】

東京都墨田区江東橋1丁目8番3-702号 ウィ

ルフォート国際特許事務所

【氏名又は名称】

宮川 長夫

出願人履歴情報

識別番号

[000001236]

1. 変更年月日

1990年 8月29日

[変更理由]

新規登録

住 所

東京都港区赤坂二丁目3番6号

氏 名

株式会社小松製作所